

物理電子システム創造専攻 平成17年度 修士中間発表会プログラム(案)

資料

2005年6月6日版

会場：G5-511

2005年6月8日

発表時間：10分 質疑5分（進学者は質疑10分）

開始時間	研究室		名前	題名	審査員	司会
9:00	宗片研	進学	押山 到	強磁性半導体の新機能を拓く研究：窒素添加による物性制御	宗片, 半那, 浅田, 梶川, 渡辺, 北本（物創）	指導教員
9:20	宗片研		武智 宏人	強磁性半導体(Ga,Mn)Asにおける光誘起歳差運動		橋本
9:35	半那研		吉澤 仁	機能性電極/液晶性有機半導体の積層構造の作製と特性評価		
9:50	半那研		豊島 剛樹	低温poly-SiGe薄膜におけるTFT実用化に向けた材料作成技術の最適化		吉澤
10:05	半那研	構想	橋本 亮平	液晶性有機半導体を用いた有機EL素子の作製		
10:20	休憩					
10:30	徳光研		谷 武夫	ゾルゲル法によるBi ₄ Ti ₃ O ₁₂ (BIT)系強誘電体メモリ材料の物性制御に関する研究		梅津
10:45	徳光研		ヤツブル アスワル	強誘電体材料の物性制御と強誘電体ゲートトランジスタへの応用		
11:00	徳光研		藩 悦	酸化物チャネルを用いた薄膜トランジスタに関する研究		
11:15	徳光研		梅津 秀文	ハフニウムアルミネートをバッファ層に用いた1T型強誘電体メモリに関する研究		谷
11:30	大見研		森 俊介	3次元構造上への高誘電率絶縁膜の形成に関する研究		
11:45	休憩					
12:45	大見研		黒瀬 朋紀	EGR Ar/O ₂ プラズマを用いた高誘電率HfON薄膜の形成とゲート絶縁膜への応用		川下
13:00	大見研		澤熊 悠	PtSiの仕事関数制御と耐熱性向上に関する研究		
13:15	大見研		高橋 博	SBSIによる極薄SOI/BOX層形成に関する研究		
13:30	大見研		川下 道宏	TML-MOSデバイス・プロセスの研究		澤熊
13:45	浅田研		後藤 隆志	2次元電子ガスをを用いた速度変調型THzデバイスの作製と増幅特性測定に関する研究		
14:00	渡辺研		諸澤 篤史	集積化に向けたSi(100)基板上フッ化物系共鳴トンネルデバイスの研究		
14:15	渡辺研		菊池 毅	弗化物系Si集積サブバンド間遷移レーザの研究		
14:30	休憩					
14:45	梶川研		福場 伸哉	金の異常反射を利用したバイオチップ		菊池
15:00	梶川研		木村 光徳	局在プラズモン共鳴を利用した光ファイバ型バイオセンサ		
15:15	梶川研		阿部 晋也	金属ナノギャップ中の増強電場による非線形光学効果		
15:30	宮本研		石田 周太郎	超格子構造による熱抵抗制御とレーザ応用		木村
15:45	宮本研		武田 一隆	波長オフセットによる高歪GaInAs/GaAs面発光レーザの長波長化		
16:00	宮本研	構想	鈴木 亮一郎	有機金属気相成長法によるGaInNAs系自己形成量子ドットを用いた長波長帯レーザに関する研究		
16:15	小林研		野口 琢也	外部鏡を用いた面発光レーザによるモード同期の研究		武田
16:30	小林研		望月 礼	LSIチップ間の超並列光接続		
16:45	植之原研		大門 真	EA変調器カスケード接続型光シリアル・パラレル変換器に関する研究		
17:00	植之原研		清水 智	光デジタル・アナログ変換型ラベル識別器の特性改善に関する研究		望月
17:15	植之原研		佐藤 佑介	波長変換を用いた光ファイバループ型バッファ回路に関する研究		
17:30	小山研		内山 泰宏	高密度面発光レーザアレイの波長制御に関する研究		
17:45	小山研		横田 康	可変機構を有する中空光導波路デバイスに関する研究		佐藤
18:00	小山研		芹澤友之	中空光導波路を用いた波長可変レーザに関する研究		
18:15	小山研	早期	長谷部 浩一	面発光レーザ構造を用いた高速偏光制御素子に関する研究	小山, 小林, 浅田, 梶川, 植之原	指導教員

物理電子システム創造専攻 平成17年度 修士中間発表会プログラム(案)

2005/6/6版

会場：G5-511 2005年6月9日 発表時間：10分 質疑5分（進学者は質疑10分）

開始時間	研究室		名前	題名	審査員	司会
9:00	宗片研(旧原研)		岡本 直也	二段階気相法によるGaN/AlN複合粒子の作製		小池
9:15	宗片研(旧原研)		堀田 繁郎	レーザ窒化によるAlN薄膜蛍光体の低温作製技術の開発		
9:30	宗片研(旧原研)		水口 祐一郎	GaN粉体を用いる電界放出素子の作製		
9:45	青柳研		早川 茂則	深紫外発光素子における高品質AlGaIn形成に関する研究		堀田
10:00	青柳研		小池 暢志郎	高効率深紫外発光素子の開発		
10:15	休憩					
10:30	青柳研	構想	内田 剛生	CNTとGaAs 2DEG を用いたエレクトロメータの作成と評価		早川
10:45	納富・小山研		森田 雅和	フォトニック結晶共振器 動的制御の研究		
11:00	伊藤研		神田 寛史	近接場光レンズを用いた原子のナノフォーカシング		内田
11:15	伊藤研		小野 一善	単一原子操作のためのbow-tieトラップの開発		
11:30	伊藤研		富永 慎	ファイバースコープを用いた冷却Rb原子の共鳴蛍光の局所観測		
11:45	休憩					
12:45	伊藤研	進学	佐藤 知広	多重近接場光スリットを用いた原子の高感度・高空間分解検出	伊藤, 益, 筒井, 徳光, 梶川	指導教員
13:05	筒井研		大前 譲治	CdF ₂ 分子線によるSi基板の表面改質の研究		富永
13:20	筒井研		杉崎 剛	異方性エッチングを用いたSi(100)基板上の弗化物共鳴トンネルダイオードの作製		
13:35	筒井研		松土 夏子	Ca _x Mg _{1-x} F ₂ 混晶のSi基板上への成長とその共鳴トンネル素子への応用		
13:50	筒井研		深川 洋太郎	プラズマドーピング法で形成した極浅p+層における電気伝導深さ方向依存性の研究		杉崎
14:05	岩井・杉井研		黒木 裕介	A Study on Mobility of La ₂ O ₃ -MISFET		
14:20	岩井研		福山 享	A Study on Metal-Insulator-Metal Structure of La ₂ O ₃ Film		
14:35	休憩					
14:45	岩井研		相庭 一穂	Feasibility Study of Plasma Doping on Si substrates with Photo-Resist Patterns		黒木
15:00	岩井研		項 瑞飛	Formation of Heat Resistant Ni Silicide by Using Heterolayers of Different Materials		
15:15	岩井研		吉崎 智史	RF Modeling of Sub-100 nm High-k MOSFET with BSIM4		
15:30	岩井研		中川 健太郎	The Effect of Y ₂ O ₃ Buffer Layer for La ₂ O ₃ Gate Dielectric Film		相庭
15:45	大見研		中光 豊	In-situ ECRプロセスによるAl/Al ₂ O ₃ 系ゲート構造の形成に関する研究		
16:00	大見研		山崎 浩史	極微細3次元SiチャネルMOSの電気的特性に関する研究		
16:15	大見研		仲西 知之	SBSIによる多層SOI技術に関する研究		中川
16:30	石原研		小原 秀一郎	トランジスタ型強誘電体メモリの動作電圧低減に関する研究		
16:45	石原研		林 大祐	CVD法により形成したRu膜を電極とした強誘電体キャパシタの研究		
17:00	有本・石原研		長谷川 聡志	MFIS-FETにおけるデータ保持特性向上に関する研究		山崎
17:15	益研		京極 貴規	配線長分布に基づく集積回路の物理設計評価手法		
17:30	益研		菅原 弘雄	再構成可能 RF CMOS 無線集積回路の研究		林
17:45	益研		杉田 英之	擬差動伝送線路を用いたオンチップ高速信号伝送技術に関する研究		
18:00	益研		ファン ダン ゴア	MOSFETスイッチを利用したオンチップ可変インダクタ		